

УДК 587.226

©1993

## РАСЩЕПЛЕНИЕ ПИКОВ ФОНОННЫХ ПОВТОРЕНИЙ В КВАЗИДВУМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

*Л.И.Коровин, С.Т.Павлов, Б.Э.Эштулатов*

На основе общей теории многофононного резонансного комбинационного рассеяния света исследован спектр фононных повторений в изолированной квантовой яме в сильном магнитном поле. Анализируется частотная зависимость тензора рассеяния в случае двух- и трехфононного рассеяния. Учтено расщепление уровней электрон-фононной системы, которое обусловлено переходами электрона между уровнями Ландау с испусканием продольных оптических фононов. Показано, что в области резонансного магнитного поля, когда циклотронная частота близка к частоте фонона, сечение рассеяния резко возрастает и перестает зависеть от фреilihовской константы связи. Если же условие резонанса не выполняется, то сечение рассеяния становится малой величиной, пропорциональной квадрату константы связи. Теория предсказывает, что в области резонансного магнитного поля пик фононного повторения расщепляется на несколько компонент, интенсивность и положение которых сложным образом зависят от величины магнитного поля.

В некоторых массивных полупроводниках на частотной зависимости сечения резонансного комбинационного рассеяния света (РКРС) наблюдаются пики, называемые фононными повторениями (ФП) [1,2]. ФП наблюдаются на частотах, удовлетворяющих условию

$$\omega_s = \omega_l - N\omega_{LO},$$

где  $\omega_s$  и  $\omega_l$  — частоты рассеянного и возбуждающего света соответственно;  $N$  — номер ФП;  $\omega_{LO}$  — частота  $LO$ -фононов, участвующих в рассеянии.

Характерной особенностью спектра ФП является слабая зависимость интенсивности пиков от номера  $N$  [3]. Теория предсказывает, что и в квазидвумерной системе эта зависимость останется слабой [4]. В магнитном поле должна появиться еще одна особенность спектра ФП, связанная с тем, что уровни электрон-фононной системы в магнитном поле расщепляются в результате взаимодействия электронов с  $LO$ -фононами [5]. Спектр ФП реагирует на расщепление уровней, что должно проявиться в возникновении у пика ФП сложной структуры. Как показывает проведенный ниже анализ, пик ФП расщепляется на несколько компонент, число которых зависит от номера  $N$  и частоты  $\omega_l$ .

В данной работе на основе общей теории многофононного РКРС исследуется спектр фононных повторений в зависимости от частоты возбуждающего света и величины магнитного поля при условии когда  $\omega_{LO} \cong \Omega$  ( $\Omega$  — циклотронная частота).

## 1. Тензор рассеяния и функции Грина

В работе [6] были получены следующие выражения для тензора рассеяния  $S_{\beta\gamma\beta'\gamma'} \equiv S$  в случае двух- и трехфононного рассеяния соответственно:

$$S_2 = S_2^{(0)} (\alpha_0/2)^2 \delta(\omega_l - \omega_S - 2\omega_{LO}) \sum C_2 W_2, \quad (1)$$

$$S_3 = S_3^{(0)} (\alpha_0/2)^3 \delta(\omega_l - \omega_s - 3\omega_{LO}) \sum C_3 W_3, \quad (2)$$

где тензоры  $S_2^{(0)}$  и  $S_3^{(0)}$  определяются как

$$S_2^{(0)} = \left( \frac{e^2}{\hbar c} \right)^2 \frac{\omega_{LO}^3 \Omega}{\omega_l^2 \omega_s^2} \frac{c^2 p_\gamma p_\beta^* p_{\gamma'}^* p_{\beta'}}{m_0^4},$$

$$S_3^{(0)} = \omega_{LO} \Omega S_2^{(0)}. \quad (3)$$

Функции  $W_2$  и  $W_3$  представляют собою произведение запаздывающих  $G$  и опережающих  $\tilde{G}$  функций Грина

$$W_2 = G(n, \omega_0) G(n', \omega_1) G(n, \omega_2) \tilde{G}(n_1, \omega_0) \tilde{G}(n'_1, \omega_1) \tilde{G}(n_1, \omega_2), \quad (4)$$

$$W_3 = G(n, \omega_0) G(n', \omega_1) G(n'', \omega_2) G(n, \omega_3) \tilde{G}(n_1, \omega_0) \times \\ \times G(n'_1, \omega_1) \tilde{G}(n''_1, \omega_2) \tilde{G}(n_1, \omega_3). \quad (5)$$

Расчет проведен для прямоугольной квантовой ямы с бесконечно высокими барьерами в приближении тяжелой дырки, когда эффективная масса электрона  $m \ll m_h$  — эффективной массы дырки. Магнитное поле  $H$  удовлетворяет условию резонанса  $\Omega \cong \omega_{LO}$ , что позволило не учитывать взаимодействие дырок с  $LO$ -фононами, так как дырка в этих условиях не может в реальном переходе испустить фонон. Дисперсия фононов не учитывалась. Формулы (1) и (2) относятся к случаю, когда в рассеянии участвует только низший уровень размерного квантования. Это имеет место, если  $\Omega \ll \omega_e$  ( $\hbar\omega_e$  — энергия размерного квантования в зоне проводимости);  $P_\alpha$  — межзонный матричный элемент импульса,  $\alpha_0$  — безразмерная фреilihовская константа связи,  $c$  — скорость света в вакууме,  $e$  — заряд электрона. Безразмерные константы  $C_2$  и  $C_3$  зависят от квантовых чисел Ландау  $n$

$$C_2 = \int_0^\infty du u^{-1} f^2(1, u) T(n, n') T(n_1, n'_1). \quad (6)$$

Функция  $f(1, u)$  определена в [6] в виде интеграла. Ее явный вид следующий:

$$f(1, u) \frac{8}{x^2 + 4\pi^2} \left\{ \frac{3x}{8} + \frac{\pi^2}{x} - \frac{4\pi^4 [1 - \exp(-x)]}{x^2 (x^2 + 4\pi^2)} \right\}, \quad (7)$$

$$x = \sqrt{ud}/l_H, \quad l_H = \sqrt{c\hbar/2eH},$$

$d$  — ширина квантовой ямы. Функция

$$T(p, q) = \frac{\min(p!, q!)}{\max(p!, q!)} e^{-u} u^{|p-q|} [L_{\sigma}^{|p-q|}(u)]^2, \quad (8)$$

$L_{\sigma}^{|p-q|}$  — полином Лагерра,  $\sigma = \min(p, q)$ . Конкретный вид константы  $C_3$  ниже не используется и она не приводится.

Для  $N$ -го ФП тензор  $S_N$ , как нетрудно показать, имеет вид ( $N \geq 2$ )

$$S_N = S_N^0 (\alpha_0/2)^N \delta(\omega_l - \omega_s - N\omega_{LO}) \sum C_N G(n, \omega_0) G(n, \omega_N) \times \\ \times \prod_{i=1}^{N-1} G(n_i, \omega_i) \tilde{G}(n, \omega_0) \tilde{G}(n', \omega_0) \tilde{G}(n', \omega_N) \prod_{j=1}^{N-1} \tilde{G}(n_j, \omega_j). \quad (9)$$

В формулах (1) и (9) суммирование проводится по  $2N$  числам Ландау. Так как все уровни системы дискретны, то  $\tilde{G} = G$ . В функции Грина входят частоты

$$\omega_{nu} = \omega_l - \omega_g - \nu\omega_{LO}, \quad \nu = 0, 1 \dots N, \quad (10)$$

$\hbar\omega_g$  — ширина запрещенной зоны. По определению,

$$G(n, \omega) = [\omega - \omega_e(n) - \omega_{LO} \sum(n, \omega)]^{-1}, \quad (11)$$

$$\omega_e(n) = \Omega(n + 1/2) + \omega_e, \quad \omega_e = \hbar\pi^2/2d^2m,$$

$\sum(n, \omega)$  — безразмерный массовый оператор, в котором учитываются все графики наибольшей расходимости, т.е. такие, в которых любая вертикальная линия пересекает не более  $n$  фоновых линий [6].

Если не учитывать графики с пересечением фоновых линий, то для массового оператора  $\sum(n, \omega)$  получаются простые формулы. Для уровня Ландау номера  $n$  массовый оператор представляет собой конечную цепную дробь с  $n$  звеньями

$$\sum(n, \omega_{\nu}) = \eta \sum_{p_1} F(n, p_1) [\Gamma(n, \nu) + \lambda_1(n, p_1) - \sum_1(n, \omega_{\nu})]^{-1}, \\ \sum_1(n, \omega_{\nu}) = \eta \sum_{p_2} F(p_1, p_2) [\Gamma(n, \nu) + \lambda_2(n, p_2) - \sum_2(n, \omega_{\nu})], \\ \dots \dots \dots \\ \sum_{n-1}(n, \omega_{\nu}) = \eta \sum_{p_n} F(p_{n-1}, p_n) [\Gamma(n, \nu) + \lambda_n(n, p_n) - \sum_n(n, \omega_{\nu})]^{-1}, \\ \sum_n(n, \omega_{\nu}) = \eta \sum_{p_{n+1}} F(p_n, p_{n+1}) [\Gamma(n, \nu) + \lambda_{n+1}(n, p_{n+1})]^{-1}. \quad (12)$$

В (12) введены безразмерные перенормированные частоты возбуждающего света

$$\Gamma(n, \nu) = [\omega_l - \omega_g - \omega_e - \Omega(n + 1/2) - \nu\omega_{LO}]/\omega_{LO} \quad (13)$$

и безразмерное отклонение магнитного поля от резонансного значения  $\Omega = \omega_{LO}$

$$\lambda_q(n, p) = [\Omega(n - p) - q\omega_{LO}]/\omega_{LO}. \quad (14)$$

Коэффициенты  $F(p, q)$  определяются интегралами

$$F(p, q) = \int_0^{\infty} du u^{-1/2} f(1, u) T(p, q). \quad (15)$$

Константа  $\eta$  связана с  $\alpha_0$  соотношением

$$\eta = (\alpha_0/2)(\Omega/\omega_{LO})^{1/2}. \quad (16)$$

## 2. Двухфононное рассеяние

Проанализируем на основе приведенных в разделе 1 формул для функций Грина частотную зависимость тензора рассеяния. Наименьшая частота  $\omega'_l$ , на которой можно наблюдать второе ФП, равна

$$\omega'_l = \omega_g + \omega_e + \omega_h + (5/2)(\Omega + \Omega_h), \quad \Omega_h = eH/m_h c. \quad (17)$$

Если имеет место прямое рождение ЭДП (электронно-дырочной пары), то сначала электрон и дырка оказываются на уровне Ландау  $n = 2$ , затем электрон в реальном переходе испускает фотон и переходит на уровень  $n = 1$ . И наконец, ЭДП аннигилирует непрямым образом, испуская квант рассеянного света и второй фотон. Этот канал рассеяния начинает работать с частоты (17). Другой канал начинается с непрямого рождения ЭДП, в результате электрон оказывается на уровне  $n = 1$ , а дырка должна быть на уровне  $n = 0$ , так как в противном случае невозможна прямая (т.е. без участия фотона) аннигиляция пары. Испустив второй фотон, электрон переходит на уровень  $n = 0$  и пара аннигилирует. Для второго канала наименьшая частота

$$\omega''_l = \omega_g + \omega_e + \omega_h + 3\Omega/2 + \Omega_h/2 + \omega_{LO}, \quad \omega_h = \hbar\pi^2/2d^2m_h. \quad (18)$$

В этом разделе рассматривается случай точного резонанса  $\Omega = \omega_{LO}$ . Тогда

$$\omega''_l = \omega'_l - 2\Omega_h < \omega'_l. \quad (19)$$

Если  $m_h \rightarrow \infty$ , что предполагается, то  $\omega''_l \rightarrow \omega'_l$ . Переходы электрона в разных каналах рассеяния показаны на рис. 1, а, б. Если  $\Omega \neq \omega_{LO}$ , то фотоны генерируются при виртуальном переходе. Сечение рассеяния при этом  $\sim \eta^2$ , т.е. является фоновым.

Рассмотрим расположение уровней электрон-фононной системы в окрестности резонанса, т.е. когда  $\Omega \cong \omega_{LO}$ , как функцию  $\Omega$ . В точке  $\Omega = \omega_{LO}$  пересекаются три терма, а именно электрон на уровне  $n = 2$ , электрон на уровне  $n = 1$  плюс один фотон и электрон на нижнем уровне плюс два фотона. Электрон-фононное взаимодействие, которое при низких температурах проявляется как спонтанное испускание фотонов,

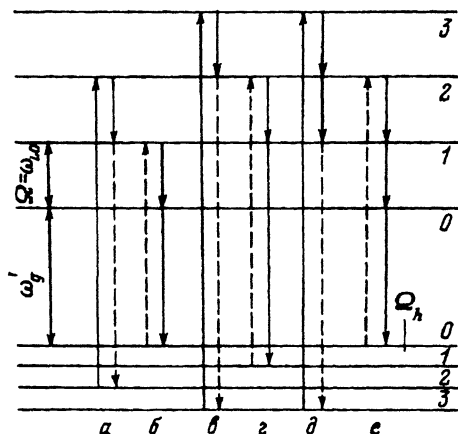


Рис. 1. Схема уровней Ландау для 2-го и 3-го фононных повторений.

Сплошные стрелки — прямые переходы, штриховые стрелки — не прямые переходы. Переходы  $a$  и  $b$  относятся к интервалу частот (32),  $v-e$  — к интервалу (33).  $a, v, d$  — канал прямого рождения;  $b, g, e$  — канал прямой аннигиляции.  $a-g$  — второе ФП;  $d, e$  — третье ФП.  $\omega'_g = \omega_g + \omega_e + \omega_h + (\Omega + \Omega_h)/2$ .

расщепляет эти уровни (рис. 2). Расщепление уровней отражается в многофононном РКРС в виде расщепления пика ФП на несколько компонент, которые соответствуют уровням электрон-фононной системы. Однако, как показано ниже, однозначного соответствия между числом уровней и числом расщепившихся пиков не существует.

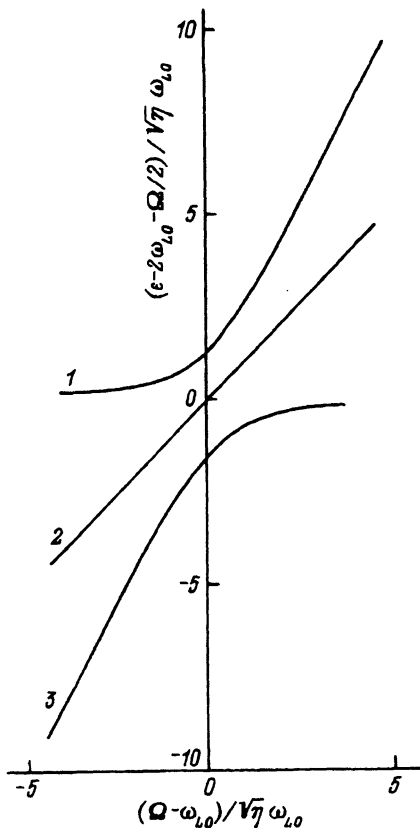


Рис. 2. Безразмерные уровни энергии электрон-фононной системы, определяемые полюсами функции (20), как функции отклонения магнитного поля от резонансного значения.

Исходным уровнем является уровень Ландау  $n = 2$ . 1, 2, 3 — номера уровней Ландау, в которые переходят ветви спектра вдали от резонанса.  $F(1, 0) = 0.886$ ,  $F(2, 1) = 0.775$ .

Резонансное усиление сечения рассеяния определяется полюсами функций Грина, входящих в выражение (1). По определению (17) в функции  $G(n, \omega_0)$  величина  $\Gamma(n, 0)$  (13) обращается в нуль, если  $n = n' = 2$ . Остальные члены двойного ряда по  $n, n'$  в (1) дают малый вклад и их можно не учитывать. Функция  $G(2, \omega_0)$  соответствует прямому рождению ЭЛП. Поскольку электрон оказывается на уровне  $n = 2$ , то имеется возможность резонансного испускания двух фононов. Поэтому в  $G(2, \omega_0)$  массовый оператор должен быть выбран в виде цепной дроби с двумя звеньями. В резонансе  $\alpha_1(2, p_1 = 1) = 0$ , т.е. в сумме по  $p_1$  в массовом операторе существенным является слагаемое  $p_1 = 1$ . По этой же причине в сумме по  $p_2$  следует оставить член  $p_2 = 0$ . Поэтому, учитывая (11), (12), функция Грина  $G(2, \omega_0)$  в резонансе представляется в виде

$$G(2, \omega_0) = \omega_{LO}^{-1} \left\{ \Gamma(2, 0) - \frac{\eta F(2, 1)}{\Gamma(2, 0) - \frac{\eta F(1, 0)}{\Gamma(2, 0)}} \right\}^{-1}, \quad (20)$$

$$\Gamma(2, 0) = [\omega_l - \omega_g - \omega_e - 5\Omega/2]/\omega_{LO}. \quad (20a)$$

Функция  $G(n', \omega_1)$  резонансна, только если  $n' = n'_1 = 1$ , т.е. она относится к электрону, находящемуся на уровне  $n = 0$ . Поскольку взаимодействие с фононами зацепляет в этом случае только уровень  $n = 0$ , то в  $G(1, \omega_1)$  достаточно использовать массовый оператор в виде цепной дроби с одним звеном, т.е. считать, что

$$G(1, \omega_1) = \omega_{LO}^{-1} \left\{ \Gamma(1, 1) - \frac{\eta F(1, 0)}{\Gamma(1, 1)} \right\}^{-1}, \quad (21)$$

$$\Gamma(1, 1) = [\omega_l - \omega_g - \omega_e - 3\Omega/2 - \omega_{LO}]/\omega_{LO} = \Gamma(2, 0). \quad (21a)$$

Функция  $G(2, \omega_0)$  отвечает непрямой аннигиляции ЭЛП, она нерезонансна и имеет вид

$$G(2, \omega_2) = -(2\omega_{LO}^{-1}). \quad (22)$$

Итак, в 4-кратной сумме в (1) за рассеяние вблизи резонанса ответственно только одно слагаемое, а именно  $n = n_1 = 2, n' = n'_1 = 1$ . Вклад остальных членов суммы  $\sim \eta^2$ . Поэтому в окрестности резонанса выражение (1) может быть представлено в виде

$$S_2 = S_2^{(0)} \delta(\omega_l - \omega_s - 2\omega_{LO}) \omega_{LO}^{-6} C_2(2, 1) w_2(2, 1), \quad (23)$$

где введена безразмерная функция  $w_2(2, 1)$ , зависящая от частоты  $\omega_l$

$$w_2(2, 1) = \omega_{LO}^6 \eta^2 W_2(2, 1), \quad (23a)$$

$$W_2(2, 1) = G^2(2, \omega_0) G^2(1, \omega_1) G^2(2, \omega_2).$$

Подставляя в (23a) функции Грина в виде (20)–(22), получим, что

$$w_2(2, 1) = (\eta/2)^2 \{ \Gamma^2 - \eta [F(2, 1) + F(1, 0)] \}^{-2} = 4^{-1} \{ v^2 - [F(2, 1) + F(1, 0)] \}^{-2},$$

$$\Gamma = \Gamma(2, 0) = \Gamma(1, 1), \quad v = \Gamma/\sqrt{\eta}. \quad (24)$$

Сингулярности  $w_2(2, 1)$  расположены в точках

$$v_{\pm} = \pm \sqrt{F(2, 1) + F(1, 0)}, \quad (25)$$

симметричных относительно  $v = 0$ .

Из (24) видно, что в области  $\Gamma \simeq \pm \sqrt{\eta}$  функция  $w_2(2, 1)$  перестает зависеть от константы связи, если же  $|\Gamma| \gg \sqrt{\eta}$ , то  $w_2(2, 1) \simeq \eta^2$ . Таким образом, в области частот, соответствующих расщепившимся пикам, рассеяние  $\sim \alpha_0^0$ , что в  $\alpha_0^{-1}$  раз больше, чем рассеяние в массовом полупроводнике [7].

В канале прямой аннигиляции резонансный вклад происходит от слагаемого  $n = n_1 = 0$ ,  $n' = n'_1$  (рис. 1, б). Вклад этого канала в тензор рассеяния определяется формулой (23), если в ней заменить  $C_2(2, 1)$  на  $C_2(1, 0)$  и функцию  $w_2(2, 1)$  заменить на

$$w_2(1, 0) = \omega_{LO}^6 \eta^2 G^2(0, \omega_0) G^2(1, \omega_1) G^2(0, \omega_2). \quad (26)$$

Учитывая (21), для  $w_2(1, 0)$  получим формулу

$$w_2(1, 0) = (\eta/2)^2 [\Gamma^2 - \eta F(1, 0)]^{-2} = 4^{-1} [v^2 - F(1, 0)]^{-2}. \quad (27)$$

Суммируя оба вклада получим, что второму ФП соответствует

$$S_2 = S_2^0 \delta(\omega_l - \omega_s - 2\omega_{LO}) \omega_{LO}^{-6} [C_2(2, 1)w_2(2, 1) + C_2(1, 0)w_2(1, 0)]. \quad (28)$$

Из (28) видно, что второе ФП состоит из четырех пиков, максимумы которых соответствуют частотам

$$\omega_{\pm 1} = \omega_g + \omega_e + 5\Omega/2 \pm \sqrt{\eta} \omega_{LO} \sqrt{F(2, 1) + F(1, 0)}, \quad (29)$$

$$\omega_{\pm 2} = \omega_g + \omega_e + 5\Omega/2 \pm \sqrt{\eta} \omega_{LO} \sqrt{F(1, 0)}. \quad (30)$$

Частотная зависимость тензора рассеяния приведена на рис. 3. Расстояние между максимумами соседних пиков равно

$$\omega_{+1} - \omega_{+2} = \sqrt{\eta} \omega_{LO} [\sqrt{(2, 1) + F(1, 0)} - \sqrt{F(1, 0)}],$$

$$\omega_{+2} - \omega_{-2} = 2\sqrt{\eta} \omega_{LO} \sqrt{F(1, 0)}, \quad \omega_{-2} - \omega_{-1} = \omega_{+1} - \omega_{+2}. \quad (31)$$

Формула (28) относится к интервалу частот

$$\omega_g + \omega_e + 5\Omega/2 \leq \omega_l < \omega_g + \omega_e + 7\Omega/2. \quad (32)$$

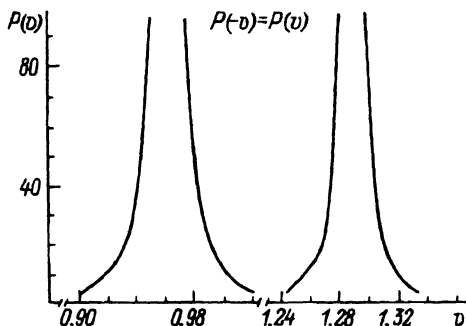


Рис. 3. Зависимость функции  $P = C_2(2, 1)w_2(2, 1) + C_2(1, 0)w_2(1, 0)$ , соответствующей второму ФП в интервале частот (32), от безразмерной частоты  $v$  в условиях точного резонанса.

$C_2(2, 1) = 0.219$ ,  $C_2(1, 0) = 0.250$ ,  
 $F(1, 0) = 0.886$ ,  $F(2, 1) = 0.775$ .

### 3. Двух- и трехфононное рассеяние в следующем частотном интервале

В частотном интервале

$$\omega_g + \omega_e + 7\Omega/2 \leq \omega_l < \omega_g + \omega_e + 9\Omega/2, \quad (33)$$

примыкающем к интервалу (32), электрон и дырка в результате прямого рождения ЭДП оказываются на уровнях  $n = 3$ . В этих условиях возможен как двухфононный, так и трехфононный процесс. Переходы электрона для второго и третьего ФП показаны на рис. 1, в, д. Уровень Ландау  $n = 3$  связан электрон-фононным взаимодействием с уровнями  $n = 2, 1$  и  $0$ , и в области резонанса, как показано на рис. 4, имеются четыре уровня электрон-фононной системы.

Для второго ФП в сумме (1) наибольший вклад в канале прямого рождения ЭДП вносит слагаемое  $n = n_1 = 3, n' = n'_1 = 2$ . Функция Грина  $G(3, \omega_0)$ , согласно определению (12), есть цепная дробь с тремя звеньями и имеет вид

$$G(3, \omega_0) = \omega_{LO}^{-1} \left\{ \Gamma_1(3, 0) - \frac{\eta F(3, 2)}{\Gamma_1(3, 0) - \frac{\eta F(2, 1)}{\Gamma_1(3, 0) - \frac{\eta F(1, 0)}{\Gamma_1(3, 0)}}} \right\}^{-1}, \quad (34)$$

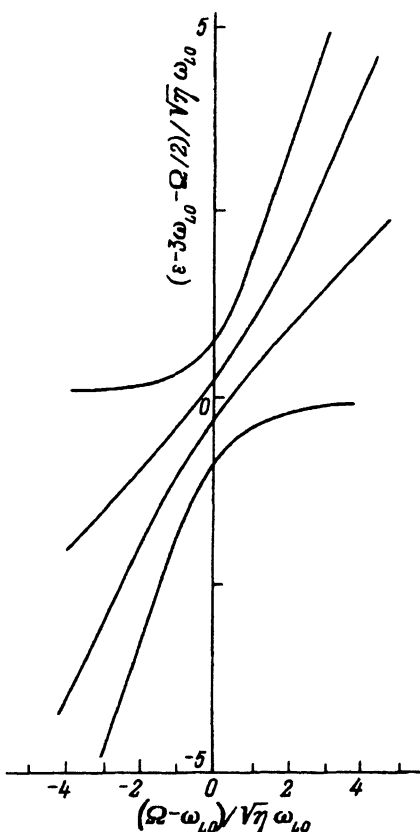


Рис. 4. Безразмерные уровни энергии электрон-фононной системы, определяемые полюсами функции (34).

Исходным уровнем является уровень Ландау  $n = 3$ .  $F(1, 0) = 0.886, F(2, 1) = 0.775, F(3, 2) = 0.705$ .



$$\Gamma_1(3, 0) = [\omega_l - \omega_g - \omega_e - 7\Omega/2]/\omega_{LO}. \quad (34a)$$

Функция  $G(2, \omega_1)$  имеет вид (18), если  $\Gamma(2, 0)$  заменить на  $\Gamma_1(2, 1) = \Gamma_1(3, 0)$ , а  $G(3, \omega_2) = G(2, \omega_2)$ . В формулу (23) вместо  $C_2(2, 1)$  следует подставить  $C_2(3, 2)$ , а вместо  $w_2(2, 1)$  — функцию

$$w_2(3, 2) = \omega_{LO}^6 \eta^2 G^2(3, \omega_0) G^2(2, \omega_1) G^2(3, \omega_2), \quad (35)$$

которая после подстановки функций Грина принимает вид

$$w_2(3, 2) = \frac{[v^2 - F(1, 0)]^2}{4\{v^4 - [F(1, 0) + F(2, 1) + F(3, 2)]v^2 + F(1, 0)F(3, 2)\}^2}, \quad (36)$$

$$v = \Gamma/\sqrt{\eta}, \quad \Gamma_1 = \Gamma_1(3, 0) = \Gamma_1(2, 1). \quad (36a)$$

Прямой аннигиляции соответствует комбинация функций Грина ( $n = n_1 = 1$ ,  $n' = n'_1 = 2$ )

$$G^2(1, \omega_2) G^2(2, \omega_1) G^2(1, \omega_0), \quad G(1, \omega_0) = (2\omega_{LO})^{-1}, \quad (37)$$

которая приводит к следующему выражению для  $w_2(1, 2)$ :

$$w_2(1, 2) = 4^{-1} [v^2 - F(2, 1) - F(1, 0)]^{-2} \quad (38)$$

Согласно (36), (38), второе ФП в интервале (33) состоит из шести пиков, четыре из них связаны с прямым рождением ЭДП и два — с прямой аннигиляцией (рис. 5). Частоты, соответствующие максимумам пиков, равны

$$v = \pm 2^{-1/2} \left[ u \pm \sqrt{u^2 - 4F(1, 0)F(3, 2)} \right]^{1/2},$$

$$v = \pm \sqrt{F(1, 0) \pm F(2, 1)}, \quad u = F(1, 0) + F(2, 1) + F(3, 2), \quad (39)$$

или, учитывая определения (34a), (36a),

$$\omega_l = \omega_g + \omega_e + 7\Omega/2 + \sqrt{\eta} \omega_{LO} v. \quad (39a)$$

Тензор рассеяния  $S_2$  принимает вид

$$S_2 = S_2^0 \delta(\omega_l - \omega_s - 2\omega_{LO}) \omega_{LO}^{-6} [C_2(3, 2)w_2(3, 2) + C_2(2, 1)w_2(2, 1)]. \quad (40)$$

В случае третьего ФП, как это следует из общего выражения (2), тензор  $S_3$  в резонансных условиях представляется в виде

$$S_3 = S_3^0 \delta(\omega_l - \omega_s - 3\omega_{LO}) \omega_{LO}^{-8} [C_3 w_3(3, 2, 1) + C_3' w_3(0, 2, 1)]. \quad (41)$$

Функция  $w_3(3, 2, 1)$  соответствует каналу прямого рождения ЭДП, когда в сумме (2) определяющим является слагаемое  $n = n_1 = 3$ ,  $n' = n'_1 = 2$ ,  $n'' = n''_1 = 1$ . Она имеет вид

$$w_3(3, 2, 1) = \eta^3 \omega_{LO}^8 [G(3, \omega_0) G(2, \omega_1) G(1, \omega_2) G(3, \omega_3)]^2, \quad (42)$$

где

$$G(3, \omega_3) = -(3\omega_{LO})^{-1},$$

а остальные функции Грина определены выше. В канале прямой аннигиляции

$$W_3(0, 2, 1) = \eta^3 \omega_{LO}^8 [G(1, \omega_2)G(2, \omega_1)G(0, \omega_2)G(0, \omega_0)]^2, \quad (43)$$

$$G(0, \omega_0) = G(3, \omega_3).$$

Подставляя выражения для функций Грина, получаем

$$w_3(3, 2, 1) = \frac{v^2}{9[v^4 - uv^2 + F(1, 0)F(3, 2)]^2}, \quad (44)$$

$$w_3(0, 2, 1) = 9^{-1}[v^2 - F(1, 0) - F(2, 1)]^{-2}v^{-2}. \quad (45)$$

Как видно из формул (44), (45), положение шести пиков третьего ФП совпадает с положением пиков второго ФП в том же частотном интервале. Кроме того, появляется центральный пик ( $v = 0$ ).

Расщеплению пиков ФП можно дать следующее качественное объяснение. Учет электрон-фонового взаимодействия приводит к тому, что вместо одного уровня Ландау с номером  $n$  появляются  $n+1$  близко расположенных уровней, расстояния между которыми  $\sim \sqrt{\eta}$ . Если  $n$  четные, то в серии уровней электрон-фононной системы имеется центральный несмещенный уровень; если  $n$  нечетное, то центральный уровень отсутствует. Число компонент пика ФП определяется квантовым числом  $n$  того уровня, на котором оказался электрон в результате рождения ЭДП. Только следует иметь в виду, что центральный уровень проявляется не в любом случае. Второму ФП в интервале частот (32) соответствуют уровни  $n = 2$  (прямое рождение) и  $n = 1$  (прямая аннигиляция). Квантовому числу  $n = 1$  соответствуют два уровня, которые и проявляются в спектре ФП (рис. 1, б). Числу  $n = 2$  соответствуют три уровня, однако во втором ФП центральному уровню пик не соответствует. С другой стороны, в третьем ФП (рис. 1, е) центральному уровню пик соответствует. Если электрон попадает на уровень  $n = 3$ , то всем уровням системы соответствуют пики ФП. Проявление центрального уровня в спектре ФП зависит от числа реальных переходов, которые совершает электрон в процессе рассеяния. Если оно максимально возможное (рис. 1, е), то центральному уровню соответствует пик. Если оно меньше (рис. 1, а, з), то центральный уровень в спектре ФП не проявляется. Такая особенность

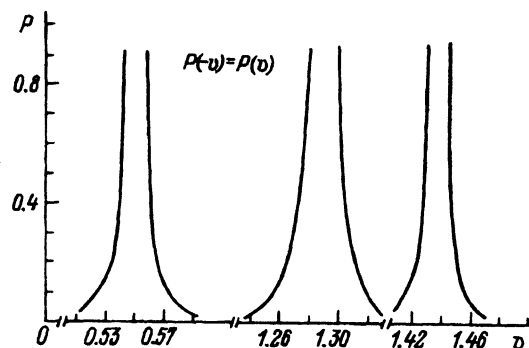


Рис. 5. Зависимость функции  $P = C_2(3, 2)w_2(3, 2) + C_2(2, 1)w_2(2, 1)$ , соответствующей второму ФП в интервале частот (33), от безразмерной частоты  $v$  в условиях точного резонанса.

$$C_2(3, 2) = 0.210, \quad C_2(2, 1) = 0.219, \\ F(1, 0) = 0.886, \quad F(2, 1) = 0.775, \\ F(3, 2) = 0.705.$$

в спектре ФП есть следствие приближенности теории. Можно показать, что если, кроме графиков максимальной расходимости, учесть меньшие по расходимости графики, то центральный пик появится, однако его интенсивность будет  $\sim \eta^2$ , т.е. близка к фоновой.

#### 4. Зависимость интенсивности пика ФП от магнитного поля

В предыдущих разделах анализ был проведен для случая, когда выполнено условие резонанса  $\Omega = \omega_{LO}$ , т.е. при фиксированном магнитном поле. Ниже рассматривается картина расщепления пика второго ФП как функция магнитного поля, т.е. когда  $\Omega \neq \omega_{LO}$ . Ограничимся интервалом (32) для частоты  $\omega_l$ . Отклонение магнитного поля от резонансного значения характеризуется параметром  $\lambda \equiv \lambda_1$

$$\lambda = \omega_{LO}^{-1}(\Omega - \omega_{LO}).$$

Если отклонение поля от резонансного невелико (т.е.  $\lambda \ll 1$ ), то в массовом операторе (12) можно ограничиться, как и в случае  $\Omega = \omega_{LO}$ , одним наибольшим членом ряда. Функции Грина  $G(2, \omega_0)$ ,  $G(1, \omega_1)$  и  $G(0, \omega_2)$ , определяющие в соответствии с (4) безразмерные функции  $w_2(2, 1)$  и  $w_2(1, 0)$ , удобно представить в виде

$$G(2, \omega_0) = \omega_{LO}^{-1} \left\{ \Gamma_0 - \frac{5\lambda}{2} - \frac{\eta F(2, 1)}{\Gamma_0 - \frac{3\lambda}{2} - \frac{\eta F(1, 0)}{\Gamma_0 - \lambda/2}} \right\}^{-1}, \quad (46)$$

$$G(1, \omega_1) = \omega_{LO}^{-1} \left\{ \Gamma_0 - \frac{3\lambda}{2} - \frac{\eta F(1, 0)}{\Gamma_0 - \lambda/2} \right\}^{-1},$$

$$G(0, \omega_2) = \omega_{LO}^{-1} \left( \Gamma_0 - \frac{\lambda}{2} \right)^{-1}, \quad (47)$$

где введена безразмерная величина  $\Gamma_0$ , не зависящая от  $\Omega$

$$\Gamma_0 = \omega_{LO}^{-1}[\omega_l - \omega_g - \omega_e - 5\omega_{LO}/2]. \quad (48)$$

Подставляя (46), (47) в формулы (23а), (26), получим выражение для функций  $w_2(2, 1)$  и  $w_2(1, 0)$

$$w_2(2, 1) = \frac{(\Gamma_0 - \lambda/2)^2}{4\left\{ \left(\Gamma_0 - \frac{5\lambda}{2}\right)\left(\Gamma_0 - \frac{3\lambda}{2}\right)\left(\Gamma_0 - \frac{\lambda}{2}\right) - \eta\left[\left(\Gamma_0 - \frac{5\lambda}{2}\right)F(1, 0) + \left(\Gamma_0 - \frac{\lambda}{2}\right)F(2, 1)\right] \right\}^2}, \quad (49)$$

$$w_2(1, 0) = \frac{1}{4\left[\left(\Gamma_0 - \frac{3\lambda}{2}\right)\left(\Gamma_0 - \frac{\lambda}{2}\right) - \eta F(1, 0)\right]^2}. \quad (50)$$

Знаменатель функции (49) представляет собой полином третьей степени относительно  $\Gamma_0$  и имеет три вещественных корня. Наиболее простое выражение для корней получается, если положить

$F(2, 1) = F(1, 0) = 1$ , что не приведет к большой неточности, так как  $F(2, 1) = 0.775$ ,  $F(1, 0) = 0.886$  (в пределе  $d/l_H \ll 1$ ). Тогда корни равны

$$\Gamma_0^{(0)} = 3\lambda/2, \quad \Gamma_0^{(\pm)} = 3\lambda/2 \pm \sqrt{\lambda^2 + 2\eta}. \quad (51)$$

Как видно из (51), при смещении магнитного поля от резонансного значения проявляется центральный пик, соответствующий корню  $\Gamma_0^{(0)}$ , который исчезает в точке резонанса. Функции  $w_2(1, 0)$  соответствуют два пика, расположенных в точках

$$\Gamma_0^{(\pm 1)} = \lambda \pm \sqrt{(\lambda/2)^2 + \eta}. \quad (52)$$

Взаимное расположение пяти пиков  $\Phi\Pi$  определяется неравенствами

$$\Gamma_0^{(-)} < \Gamma_0^{(-1)} < \Gamma_0^{(0)} < \Gamma_0^{(+1)} < \Gamma_0^{(+)}. \quad (53)$$

В заключение рассмотрим зависимость интенсивности пика рассеянного света от магнитного поля. Полученные выше выражения для тензора рассеяния неудобны для исследования интенсивности, так как содержат сингулярности. Чтобы их устранить, во-первых, перейдем от дифференциального сечения к сечению, проинтегрированному по всем частотам  $\omega_s$ . Обозначим проинтегрированный по частотам тензор рассеяния через  $\tilde{S}$

$$\tilde{S} = \int_0^\infty d\omega_s S(\omega_s). \quad (54)$$

Очевидно, что  $\tilde{S}$  отличается от тензора  $S$  только отсутствием множителя  $\delta(\omega_l - \omega_s - 2\omega_{LO})$ . Во-вторых, введем формально уширение электронных уровней, т.е. заменим величину  $\Gamma(n, \nu)$ , определенную в (13), на

$$\tilde{\Gamma} = \Gamma(n, \nu) + i\delta_0, \quad (55)$$

где константа  $\delta_0$  определяет уширение уровней. Механизм уширения не конкретизируется. При расчете функций  $w_2$  и  $w_3$  следует учесть, что ввиду комплексности  $\tilde{\Gamma}$  вместо  $G^2(n, \omega_0)$  теперь входят  $|G(n, \omega_\nu)|^2$ . С учетом этого обстоятельства  $w_2(2, 1)$  и  $w_2(1, 0)$  представляются в виде

$$w_2(1, 0) = 4^{-1}[(v - 3\mu/2)(v - \mu/2) - F(1, 0)]^{-2}, \quad (56)$$

$$w_2(2, 1) = \frac{(v - \mu/2)^2}{4[(v - v_{-1})^2 + \delta^2][(v - v_0)^2 + \delta^2][(v - v_{+1})^2 + \delta^2]}, \quad (57)$$

где

$$v = \Gamma_0/\sqrt{\eta}, \quad \delta = \delta_0/\sqrt{\eta},$$

$v_{\pm 1}, v_0$  — корни кубического уравнения

$$(v - \frac{5\mu}{2})(v - \frac{3\mu}{2})(v - \frac{\mu}{2}) - [(v - \frac{5\mu}{2})F(1, 0) + (v - \frac{\mu}{2})F(2, 1)] = 0. \quad (58)$$

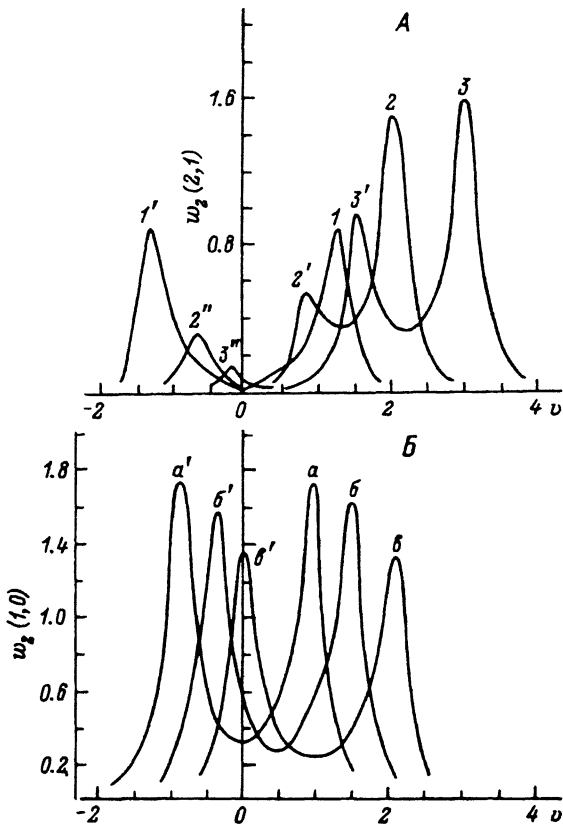


Рис. 6. Функция  $w_{2,1}(1,0)$  и  $w_2(2,1)$ , определяющие тензор рассеяния в интервале частот (32), при некоторых значениях параметра  $\mu$ .

A — канал прямого рождения,  
 Б — канал прямой аннигиляции.

$F(1,0) = 0.886$ ,  $F(2,1) = 0.775$ .

$\mu = 0(1, 1'; a, a')$ ,  $0.5(2, 2', 2''; b, b')$ ,  
 $1(3, 3', 3''; a, a')$ .

Зависимость функций  $w_2(2,1)$  и  $w_2(1,0)$  от безразмерной частоты  $\nu$  для различных значений магнитного поля приведена на рис. 6. Как видно из приведенных формул и рис. 3, 5, 6, теория предсказывает сложную зависимость положения и интенсивности пиков фоновых повторений от магнитного поля. Для второго ФП в точном резонансе ( $\mu = 0$ ) тензор рассеяния состоит из четырех симметричных относительно точки  $\nu = 0$  пиков. С ростом магнитного поля (область  $\mu > 0$ ) в канале прямого рождения (рис. 6,а) преобладающим становится пик, соответствующий переходу на уровень  $n = 2$  (кривая 1 на рис. 2), который смещается в сторону больших  $\nu$ , в то время как остальные пики (кривые  $3'$  и  $3''$ ) затухают. В канале прямой аннигиляции (рис. 6,б) картина иная — с ростом магнитного поля интенсивность обоих пиков уменьшается одинаково, они также смещаются в сторону больших  $\nu$ . Уменьшение интенсивности пиков, кроме одного, объясняется уходом системы от точного резонанса, когда переходы  $1 \rightarrow 2$  и  $2 \rightarrow 3$  (рис. 2) становятся менее эффективными и соответственно ослабевает влияние уровней 2 и 3 на формирование спектра ФП. Число пиков фоновых повторений, которое можно наблюдать, зависит от константы затухания  $\delta_0$ . При значении  $\delta_0 = 0.2\sqrt{\eta}$ , для которого проводился численный расчет, число пиков второго ФП уменьшается за счет слияния части из них.

Как видно из рис. 6, в резонансе  $\mu = 0$  вместо четырех пиков будут наблюдаться два, так как пики  $1'$  и  $a'$ , а также  $1$  и  $a$  при составлении комбинации  $C_2(2,1)w_2(2,1) + C_2(1,0)w_2(1,0)$  сливаются. При  $\mu = 0.5$  сливаются пики  $2'$  и  $b'$ , и в этом случае проявляются четыре пика. То же самое имеет место в случае  $\mu = 1$ , когда сливаются пики  $e'$  и  $z''$ . Зависимость функций  $w_2(2,1)$  и  $w_2(1,0)$  от  $v$  для  $\mu < 0$  может быть получена из условия  $w_2(-\mu, -v) = w_2(\mu, v)$ .

Развитая выше теория предсказывает для квантовой ямы резкое увеличение рассеяния в процессе многофононного РКРС. В резонансной области тензор рассеяния перестает зависеть от константы связи, в то время как вдали от резонанса он пропорционален ее квадрату. Таким образом, при достаточно малых значениях константы связи можно ожидать увеличение сечения рассеяния в области резонанса в тысячи раз. Подчеркнем, что удельное рассеяние в квазидвумерной системе оказывается в  $\eta^{-1}$  раз сильнее, чем аналогичное рассеяние в массивном образце. Поведение пиков ФП вблизи резонанса как функция магнитного поля отражает спектр электрон-фононной системы. Расщепление электрон-фононных уровней приводит к разбиению пика ФП на несколько компонент, интенсивность которых сложным образом меняется как функция магнитного поля. Каждый пик представляет собою суперпозицию двух наборов пиков, соответствующих двум каналам рассеяния, положение и интенсивность которых по-разному зависят от магнитного поля.

Теория предсказывает, что расстояние между компонентами пиков ФП  $\sim \sqrt{\eta}$ . Вопрос о численном множителе в данной теории остается открытым, так как при вычислении массовых операторов не учитывались графики с пересечением фононных линий. Однако, принимая во внимание результаты работы [8], изменения, связанные с учетом этих графиков, будут невелики.

В данной работе рассматривались только двух- и трехфононные РКРС в двух частотных интервалах. Развитая методика расчета позволяет вычислить РКРС с участием любого числа фононов.

### Список литературы

- [1] Merlin R., Güntherodt G., Humphreys R. // *Semicod. Instr. Phys. Conf. Series*. 1978. V. 43. P. 857.
- [2] Yoshida M., Ohno N., Mitsutake H., Nakamura K., Nakai Y. // *J. Phys. Soc. Japan*. 1985. V. 54. N 7. P. 2754-2761.
- [3] Martin R.N. // *Phys. Rev.* 1974. V. B10. P. 2620.
- [4] Коровин Л.И., Павлов С.Т., Эшпулатов Б.Э. // *ЖЭТФ*. 1991. Т. 29. № 5. С. 1619-1631.
- [5] Коровин Л.И., Павлов С.Т., Эшпулатов Б.Э. // *ФТТ*. 1991. Т. 33. № 3. С. 968-970.
- [6] Коровин Л.И., Павлов С.Т., Эшпулатов Б.Э. // *ФТТ*. 1993. Т. 35. № 6. С. 1562-1576.
- [7] Белицкий В.И., Гольцев А.В., Ланг И.Г., Павлов С.Т. // *ЖЭТФ*. 1984. Т. 86. С. 272-286.
- [8] Коровин Л.И. // *ФТТ*. 1971. Т. 13. № 3. С. 842-848.

Физико-технический институт  
им. А.Ф.Иоффе РАН  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
1 февраля 1993 г.